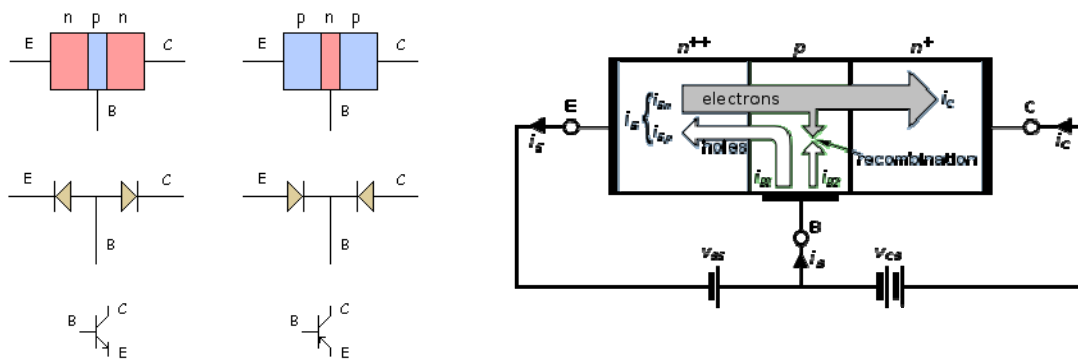


1.5 El transistor bipolar. Fonaments



- No es pot construir un transistor BJT amb dos díodes en oposició
- La zona de la Base és molt més estreta: $B \ll E < C$
- No és un dispositiu simètric. El dopatge és diferent: $E > C \gg B$